(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年9月4日(04.09.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/183182 A1

(51) 国際特許分類:
G03F 7/11 (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/007230

(22) 国際出願日： 2025年2月28日(28.02.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-031430 2024年3月1日(01.03.2024) JP

(71) 出願人：日産化学株式会社(**NISSAN CHEMICAL CORPORATION**) [JP/JP]；〒1036119 東京都中央区日本橋二丁目５番１号 (JP).

(72) 発明者：木下 和彦 (**KINOSHITA Kazuhiko**)；〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉６３５ 日産化学株式会社材料科学研究所内 (JP). 西田 登喜雄(**NISHITA Tokio**)；〒9392792 富山県富山市婦中町笹倉６３５ 日産化学株式会社材料科学研究所内 (JP).

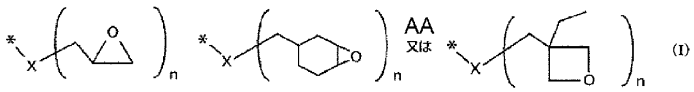
(74) 代理人：高岡 亮一，外 (**TAKAOKA Ryoichi** et al.)；〒1710021 東京都豊島区西池袋５－４－７ 池袋トーセイビル５階 高岡ＩＰ特許事務所 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能)：AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能)：ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,

(54) **Title:** SEMICONDUCTOR ELEMENT-FORMING COMPOSITION

(54) 発明の名称： 半導体素子形成用組成物



AA or

(57) **Abstract:** Provided is a semiconductor element-forming composition that is for use in forming circuits or the like for a semiconductor device and that satisfactorily has all of good applicability, curability of film in a short period of time, and good storage stability. This semiconductor element-forming composition comprises: (A) a compound or a polymer having a reactive group indicated by a cyclic ether structure represented by formula (I); (B) a compound or a polymer having a reactive group that has reactivity to the reactive group in (A); (C) a basic curing agent; (D) an acidic additive; and (E) a solvent. (In formula (I), * represents a binding site. n represents 1 or 2. When n equals 1, X represents an ether bond, an ester bond, or an amide bond, and, when n equals 2, X represents a nitrogen atom or an amide bond.)

(57) 要約：半導体装置の回路形成等に使用される半導体素子形成用組成物であって、良好な塗布性と短時間での膜硬化性、良好な保存安定性の全てを満足できる半導体素子形成用組成物を提供する。（Ａ）下記式（Ｉ）で表される環状エーテル構造で示される反応基を有する化合物又は重合体：（Ｂ）前記（Ａ）における反応基に対して反応性を持つ反応基を有する化合物又は重合体：（Ｃ）塩基性硬化剤：（Ｄ）酸性添加剤：及び（Ｅ）溶剤、を含む、半導体素子形成用組成物である。（式（Ｉ）中、＊は結合部位を示す。ｎは１又は２を表す。ｎ＝１のときＸはエーテル結合、エステル結合、又はアミド結合を表し、ｎ＝２のとき、Ｘは、窒素原子又はアミド結合を表す。）

WO 2025/183182 A1

［続葉有］

CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）